## BL46XU 産業利用Ⅲ

BL46XUは標準アンジュレータを光源とし、主として硬 X線電子分光とX線回折を測定手法とした利用実験に供さ れている。2010年度、硬X線電子分光装置では成果専有課 題の増加に伴い、測定スループットの向上とユーザーフレ ンドリーな測定環境整備のため、試料移送機構の改良と測 定プログラムのバージョンアップを実施した。X線回折装 置では新しい測定技術開発として、ユーザーと協力して水 中の固液界に形成した吸着膜のX線反射率測定を行う技術 を開発した。

1.硬X線光電子分光 (Hard X-ray Photoemission Spectroscopy:HAXPES)

2010年度は試料移送機構の改良とR-4000 測定プログラ ムのバージョンアップを行った。

試料交換に要する時間は2009年に導入したロードロック 機構により大幅に短時間化したが、測定室と試料移送室の 間をバルブで仕切るために試料移送棒の長さが約900 mm と長くなった。試料交換を行う際には、この長い移送棒を 手で支え平行を維持しながらマニピュレータに取り付ける ため試料が試料移送室の内壁に衝突して試料面を損傷する ことがたびたび発生した。そこで、移送中の試料衝突を回 避するために移送棒を確実に支えるガイドを製作した。こ のガイドの導入後によりガイドレール上で移送棒をスライ ドさせることで平行を保ちながら試料棒を移動することが 可能でマニピュレータへ試料移送棒の取り付けが容易にな り、試料交換時間をさらに約20分短縮する事ができた(図1 を参考)。



図1 試料移送棒のガイドの実際の図

BL46XUの硬X線光電子分光装置の測定プログラムは観 測する光電子の運動エネルギーに誤った値を入力すると、 急激な昇圧によりアナライザーの放電や電源ボートの破損 が発生する恐れがあった。今回導入した新しい制御プログ ラム (SES 1.2.6) は電圧昇圧レートの設定が可能となり、 装置の操作性が大きく向上した。

2010年度は、現有のR-4000に加えて、運動エネルギー 15 keVの光電子を測定できるFOCUS社製 HV-CSA 300/15を光電子エネルギー分析器に導入した。本装置の導 入により、例えばSiO<sub>2</sub>の場合、分析深さは通常8 keVで運 用しているR-4000装置に比べ、約20 nmから約30 nmまで 向上する。また、10~15 keVの間には、Ga、Ge、Asの各 K穀や、Hf、Ta、W、Pt、Auの各L殼など産業応用上重 要な元素のエネルギー準位が多数存在しているという点で も魅力的である。本装置は2010年度末に納入され2011年度 に本装置の立上げ及び性能評価を行う予定である。

## 2. X線回折計(多軸回折計,薄膜構造評価用X線回折計)

多軸回折計を用いて水中の固液界に形成した厚さがナノ メートルオーダー吸着膜のX線反射率(X-ray Reflectivity: XR) 測定を行う技術を、宇都宮大学 飯村准教授のグルー プと協力して開発した。この技術において水によるX線の 強い吸収による信号の減衰への対応が必要であるが、平行 性に優れた高エネルギーのX線(20 keV)を利用するとと もに、このエネルギーで十分な透過X線強度を確保できる 専用の試料セルを開発した(図2)。試料セルはアルミ製で、 X線の上下流側面にカプトンフィルムのX線窓を設け、セ ル内部に液体を保持できるようにし、この液体を満たした 試料セルの底部に吸着膜を形成させる固体基板を沈めた。 なお、セル上部には注水及び排水用のチューブを設置し、 セル内部の溶液をマイクロポンプを用いて連続的に置換で きる機構とした。基板上の固/液界面に対し、カプトンフ ィルムを透過したX線を液体(水)側から入射し、XRを 測定した。

図3に測定例を示す。各測定試料は、①シリコンウエハ (最表面は自然酸化膜、Si/SiO<sub>2</sub>) ②同基板表面を、ウレイ ドプロピルトリエトキシシラン (UPTES) 単分子膜で被 覆した試料 (UPTES) ③ ②の測定の後、セル内の超純水 を界面活性剤 (長鎖アルコールとカチオン性界面活性剤) (CD) とアニオン性高分子 (P) を含む水溶液に置換し、 更に、異なる量の超純水で置換(洗浄)した試料(CDP、 洗浄量240、480、720 mL)、及び④ ②の測定の後、CDの みの水溶液で置換し、超純水480 mLで洗浄した試料(CD、



図2 入射側(左図)と反射側(右図)の機器配置

480 mL)である。ただしこれらのXRプロファイルは、見 やすくするために、反射率を10<sup>-1</sup>ずつずらしてプロットし ている。これらのデータが示す通り、反射率10<sup>-9</sup>程度まで の良好なXR曲線を得ることに成功した。また、この図中 には、Si/SiO<sub>2</sub>、UPTES、CDPとCDの480 mL洗浄試料に ついては、ボックスモデル解析によって得られた現時点で のベストフィットパラメータを用いて計算されたXR曲線 も重ねて示した。これらの解析結果において、シリコンウ エハ/超純水界面に対するXR曲線(①)は、Si層と自然 酸化層(SiO<sub>2</sub>)の電子密度をそれぞれ、シリコンウエハに 対して報告されている値である0.71 Å<sup>-3</sup>と0.67 Å<sup>-3</sup>として計 算したフィッティング曲線と良く一致した。このことから、 本実験の装置系及び測定条件により、水中での固/水界面



のX線反射率が正しく測定できていることが確認された。

産業利用推進室 産業利用支援グループ 小金澤 智之、佐藤 真直 廣沢 一郎、陰地 宏、孫 珍永